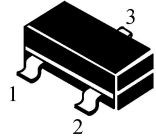




GMBTA06

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

NPN Low Frequency Amplifier Transistor

■MAXIMUM RATINGS 最大額定值($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	80	Vdc
-Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	80	Vdc
Emitter-Base voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	4.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I_C	500	mAdc
Base-Current 基極電流	I_B	50	mAdc
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_C	300	mW
Junction Temperature 結溫	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature Range 儲存溫度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

■DEVICE MARKING 打標

GMBTA06(MMBTA06)=1GM

GMBTA06

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=80\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	μA
Collector Emitter Current 集電極發射極電流	I_{CES}	$V_{CE}=60\text{V}, V_{BE}=0$	—	—	0.1	μA
Collect-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	80	—	—	V
Collect-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	80	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}$	4	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=10\text{mA}$	100	—	—	—
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=100\text{mA}$	100	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	—	0.25	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	—	1.2	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極電壓	V_{BE}	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=100\text{mA}$	—	—	1.2	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=10\text{mA}$	100	—	—	MHz